

2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2, КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2

Бескорпусные высокочастотные биполярные р-р-р транзисторы малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_T = 350$ МГц

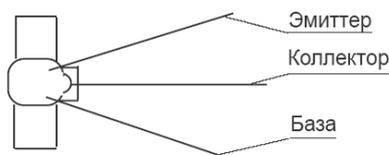
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{кmax} = 30$ мВт

Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэmax} = 20$ В

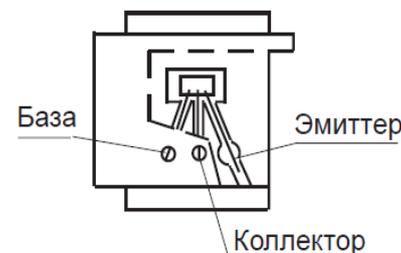
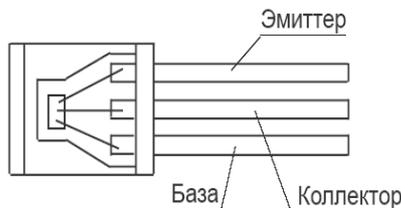
Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса
2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2	ЩТЗ.365.059 ТУ	Без корпуса, сопроводительная тара ТС4, ТС16
КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2	ЩТЗ.336.011 ТУ	

Бескорпусные на кристаллодержателе (подложке) с защитным покрытием и гибкими выводами кремниевые планарно-эпитаксиальные р-р-р усилительные и переключающие транзисторы 2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2, КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры. Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям ЩТЗ.365.059 ТУ и ЩТЗ.336.011 ТУ. Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности. Размеры кристалла 0,7 x 0,8 мм.

Схема расположения выводов



Сопроводительная тара



**2Т364А-2, 2Т364Б-2, 2Т364В-2
КТ364А-2, КТ364Б-2, КТ364В-2**

ТС4

ТС16

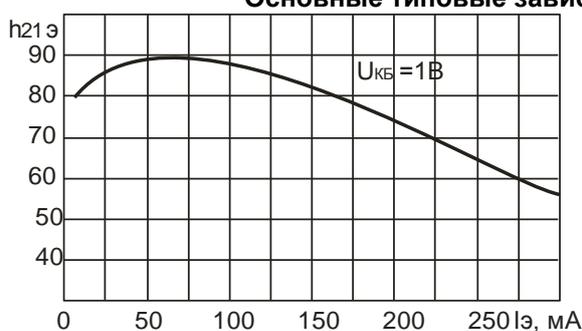
Основные электрические параметры при температуре: 0°C ÷ +70°C

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	2Т364А-2 КТ364А-2		2Т364Б-2 КТ364Б-2		2Т364В-2 КТ364В-2	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{кб}=25$ В), мкА	$I_{кбо}$		1		1		1
Обратный ток эмиттера ($U_{эб}=5$ В), мкА	$I_{эбо}$		1		1		1
Статический коэффициент передачи тока ($U_{кб}=1$ В, $I_э=100$ мА, $t_и \leq 2$ мс)	$h_{21э}$	20	70	40	120	80	240
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{кб}=2$ В, $I_э=10$ мА, $f=100$ МГц)	$ h_{21э} $	2,5		2,5		2,5	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_к=100$ мА, $I_б=10$ мА)	$U_{кэнас}$		0,3		0,3		0,3
Напряжение насыщения база- эмиттер ($I_к=100$ мА, $I_б=1$ мА), В	$U_{бэнас}$		1,1		1,1		1,1
Постоянная времени цепи обрат- ной связи на высокой частоте, пс ($U_{кб}=2$ В, $I_э=5$ мА, $f=5$ МГц)	$\tau_к$		500		500		500
Емкость коллекторного перехода ($U_{кб}=5$ В, $f=5$ МГц), пФ	$C_к$		15		15		15
Емкость эмиттерного перехода ($U_{эб}=0$ В, $f=5$ МГц), пФ	$C_э$		30		30		30
Время рассасывания, нс ($I_к=100$ мА, $I_б=1$ мА)	$t_{рас}$		100		130		160

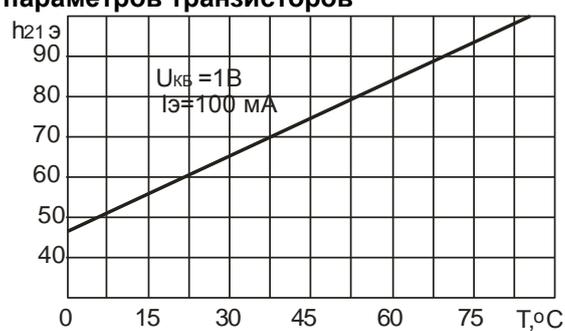
Пределные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т364А-2 КТ364А-2	2Т364Б-2 КТ364Б-2	2Т364В-2 КТ364В-2	Примечание
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	25	25	25	
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$, В	$U_{КЭ\max}$	20	20	20	
Максимально – допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	5	5	5	
Максимально – допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\max}$	200	200	200	
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 10$, мА	$I_{КИ\max}$	400	400	400	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт при $T = +25^\circ\text{C}$ при $T = +85^\circ\text{C}$	$P_{К\max}$	30	30	30	
		12	12	12	
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Т-с}$	3300	3300	3300	
Температура перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{п}$	125	125	125	

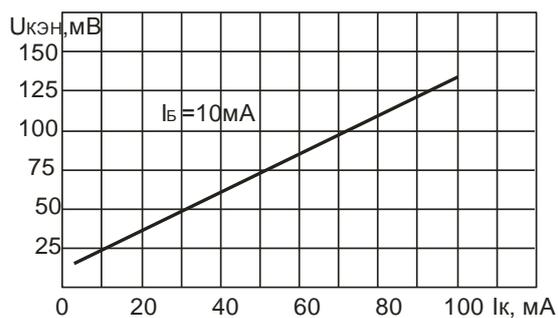
Основные типовые зависимости параметров транзисторов



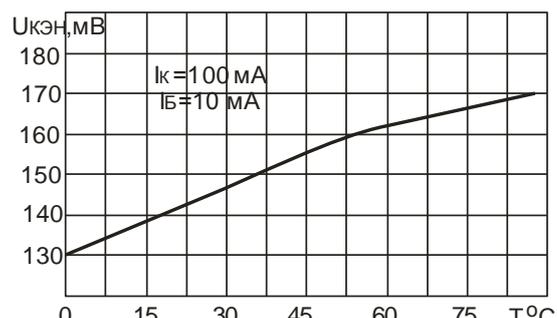
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



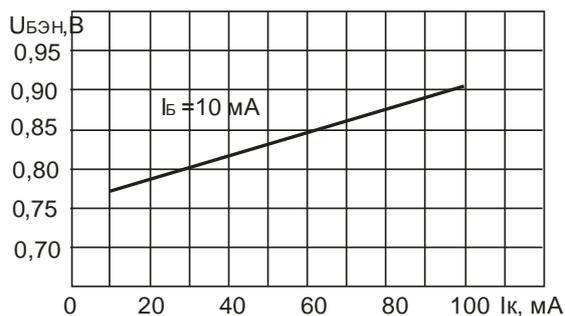
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



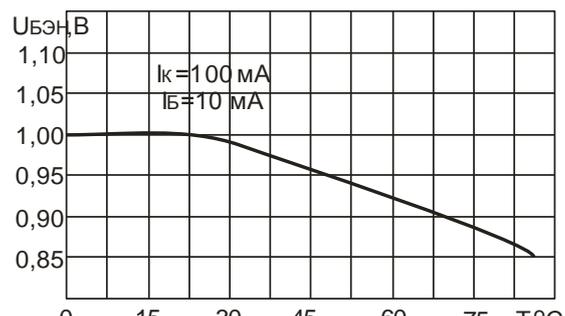
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от температуры